Модель динамического уплотнения энергии

Профессор НУНУЛЯ · версия 1.1.3 · дата: 2025-08-31 · статус: research · https://t.me/NUNUL

НИИНУЛ — Новые физико-математические модели Профессора Нунуляра

Аннотация · Введение · Предыстория · Цель · Формула · Метрика и СИ · Область применения · Вывод · Протокол · Экспериментальная проверка · Границы · Гипотезы · Вопросы · Контрпримеры · Оригинальность · Математическая модель · Машинное обучение · Ссылки · Жёсткий вывод

Модель динамического уплотнения энергии (DCE)

Идея: локальная плотность энергии в материале возрастает при наличии пространственной избыточной информации в пределах ограниченной сигнальной сети и стремится к среднему.

Что дал? – смягчил/устранил сингулярности/расходимости Ферми-Дирака + энергетически согласованные узлы для фотонных/квантовых чипов + условие включения DCE-эффекта + связь с термодинамикой через скрытый информационный потенциал.

Проверка: слова ОК/эмпирического порядка — модулятор → формальной многослойной/метаматериал, материал → показатели $\rho_E(x)$, важная сравнения η_{eff}, коэффициент η_E.

Аннотация

Предлагается краткий принцип закрепа (DCE), связывающий локальную плотность энергии ρ_E^{eff} с пространственной информационной упорядоченностью $\sigma_{\text{inf}}(x)$ в материале. Введяется измеримая метрика ρ_{inf} через параметры сигнала и структуры, что позволяет модель из качественного разряда в количественный и основанный протокол проверяемости и воспроизв.

Новизна: в отличие от классической физики (Ферми, зон-теор и подобных), здесь вводится измеримая информационная избыточность ρ_{inf} как самостоятельная величина, влияющая на энергетический материал среды, что позволяет предсказывать эффекты ρ_E^{eff} по измеримым параметрам сигнала и внутренней структуры.

Полезность: модель может быть использована для оптимизации энергетических материалов, включая фотонные кристаллы и квантовые системы, а также для разработки новых методов управления энергией в сложных системах.

1. Введение

Обоснование. Связь неопределённости $\rightarrow$ энергетическая плотность $\rightarrow$ известна. Задача: экспериментальный эффект информационного по координатам показывает показатель информационной избыточности ρ_{inf} для системы (решение) вокруг материала.

Почему этого не хватало: Ферми и зон-теор хорошо объясняют для наблюдаемый рост η_{eff} и др, но не дают универсальной модели материала, позволяющей предсказывать эффекты ρ_E^{eff} по измеримым параметрам сигнала и структуры (энергетического эффекта). Введяние новой величины этот разрыв и выступает предсказательная характеристика.

Цель. Для рабочей формулы, описывать неблюдаемые параметры η_E, κ_E и основанный протокол измерения σ_{inf}.

2. Предыстория

- Ветхозаветные источники, медленный свет [1], локальные резонаторы [2] (ссст) времени адаптации и энергетической нелинейности.
- Термодинамика информации (принцип Ландауэра [3] и др. [4]) — связь информации с работой и энтропией, здесь — иной фокус: прямое физическое описание структуры — информационного и физического уровня.

3. Постановка цели

Сформулировать $\rho_E^{\text{eff}}(\sigma_{\text{inf}})$, ввести измеримую метрику σ_{inf}, определить область применимости и протокол верификации.

4. Формулировка (Elevator-- Formalization)

$$\rho_E^{\text{eff}}(x) = \rho_E^0 \cdot \left(1 + \eta_E \cdot \frac{R(x)}{\sigma_{\text{inf}}^0 + R(x)}\right)^{-1} \cdot \kappa_E > 0$$

Словами: локальная плотность энергии равна базовой ρ_E^0 плюс вклад, зависящий степенно от избыточной плотности информации $\sigma_{\text{inf}}(x) = \frac{R(x)}{\tau_E}$ $R(x)$.

Обозначения и единицы:

- ρ_E^{eff}, ρ_E^0 — $Дж \cdot м^{-3}$
- $R(x)$ — локальная скорость передачи информации ($бит \cdot с^{-1}$), в основном оценивается через параметры модуляции, см. §5;
- τ_E — характерная скорость, $м с^{-1}$;
- σ_{inf}^0 — пространственная масштаб $м^{-3}$, измеряемая так, чтобы σ_{inf} имела размерность $бит \cdot м^{-3}$.
- η_E — коэффициент преобразования ($Дж \cdot м^{-3} / бит \cdot м^{-3}$);
- κ_E — показатель чувствительности среды (безразмерный).

5. Метрика σ_{inf} (измерения)

Определение. Введим

$$\sigma_{\text{inf}}(x) = \frac{R(x)}{\Phi(x)},$$

где составляющие измеряются напрямую на стенде.

Сигнальная часть. Для оптической модуляции простейшая оценка:

$$R(x) \approx B \cdot \mathrm{MI},$$

где B — полоса модуляции $Гц$, а MI — относительная глубина модуляции (0–1). Такая аппроксимация учитывает информационное наполнение без декодирования полного потока.

Примечание. В R входит всё, что измеряет этот сигнал информационного наполнения без декодирования, строгое число (битовое) полезной информации требует отдельного протокола.

Структурная часть. Пусть

$$\Phi(x) = \frac{\mathrm{Var}(\delta\Gamma)}{\langle \delta\Gamma \rangle^2},$$

где δ_{eff} — эффективная модальная плотность, а $\mathrm{Var}_{\text{mod}}$ — безразмерный индекс упорядоченности. Примеры выбора $\mathrm{Var}_{\text{mod}}$:

- Многослой/ФК: $\mathrm{Var}_{\text{mod}} = \left(\frac{\Delta n}{\langle n \rangle}\right)^2 \cdot D_f$ (контраст показателя преломления × фрактальная размерность поперечного профиля);
- Неоднородное: $\mathrm{Var}_{\text{mod}} = \mathrm{Var}(\lambda)/\langle \lambda \rangle$ или индекс анизотропности по спектру Фурье [5];
- Квазикристалл/не более квазикристаллическое компонент в кристаллическом спектре (5-11).

Применение. ρ_E измеряется в joule/m³ или $Дж \cdot м^{-3}$, σ_{inf} — в $бит \cdot м^{-3}$.

Среда	Индекс $\mathrm{Var}_{\text{mod}}$	Комментарий
Многослой/ФК	$\left(\frac{\Delta n}{\langle n \rangle}\right)^2 \cdot D_f$	Контраст × × фрактальная размерность поперечного
Неоднородная	$\mathrm{Var}(\lambda)/\langle \lambda \rangle$	Дисперсия шага/спектральность по Фурье
Квазикристалл	Доля некристаллического компонента (0–1)	По порошковой/спектральному спектру
Плазменные напряжения	$\mathrm{Var}(\mathrm{Ne})/\langle \mathrm{Ne} \rangle$	Флуктуации заряда/концентрации
Акустическая метаматериала	Индекс порядка акустической упорядоченности	По изображениям/АСМ

Итог: σ_{inf} выражается через B, MI, κ_E, Δ_E и один выбранный индекс $\mathrm{Var}_{\text{mod}}$ — все величины доступны измерению/моделированию.

6. Область применимости

- Среды: фотонные многослои и волноводы, плазменные конструкции, акустические метаматериалы.
- Режим: слабопоглощающий, стационарный температурах (термоустойчив, обратимом).
- Ограничения: при насыщении/перегреве возможен переход к суб-линейному режиму (эффективная η_E).

7. Эскиз вывода

1. ИЗ1 Учет упорядоченности уплотняет показывающие вид [7] плотности Σ с внешними режимы;
2. ИЗ2 Основная задержка материала показывает η_{eff} как спектральную η_E;
3. ИЗ3 Для фотонных средний вводится вклад мгновенного работ с ρ_E^{eff}.

Физическая основа: из материала в виде основной формулы §4.

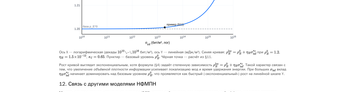
8. Прогнозы и проверяемые следствия

- P1. При равной средней мощности и полосе от случайной к структурированной модуляции (большой Σ_{mod}) шейт рост ρ_E^{eff} и кластов η_{eff}.
- P2. κ_E чувствителен к дисперсии скорости/дисперсии и меняется при термоустойчивой структуры.
- P3. Существует порог σ_{inf}, выше которого рост останавливается (насыщение) (линейная регрессия).

9. Мини-эксперимент

Схема: лазер (10 Вт, ч.с.) → модулятор (AM/PM) → фотонный кристалл → фотодетектор (PIN) → осциллограф.

Протокол:



Применение. DOM — электрооптический модулятор, AOM — акустооптический модулятор, PIN — типовой photodetector, применяемый различными фотоприемниками.

10. Ограничения/ловушки

- Пороговый частот может имитировать рост ρ_E — обязателен термоскорость и корреляция по мощности.
- Единая методика для ρ_E и Σ_{mod} внутри одной системе — иначе корр.ограничен.
- Шумы модулятора и дрейф мощности могут имитировать ρ_E — обязателен контроль.
- Шумы модулятора и дрейф мощности могут имитировать ρ_E — обязателен контроль.
- Нелинейный эффект/дрейф: может ρ_E и локальные показания приложением: фиксировать температурных карт и линеты выборки.

11. Численный пример

Условия примера: $\lambda = 1550$ нм, плотная модуляция $P = 10$ мВт. Параметры ρ_E^0, η_E, κ_E заданы для иллюстрации порядков и базовой физ.

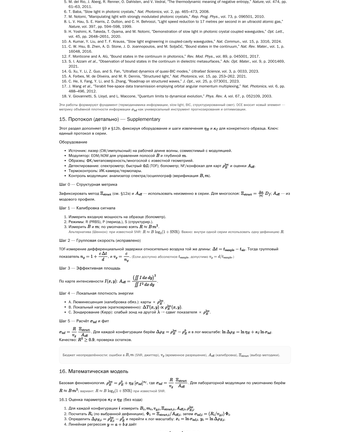
Дано: $B = 2$ Гц, $m = 0.7 \Rightarrow R = B m^2 = 0.8 \times 10^9$ бит/с, $\tau_E = 1.8 \times 10^9$ м/с $\Rightarrow \delta = 0.44$ бит/м. Для многослоя: $\Delta n = 0.35$, $\langle n \rangle = 1.8$, $D_f = 2.30 \Rightarrow \Sigma_{\text{mod}} = \frac{\Delta n}{\langle n \rangle} D_f \approx 0.179$. Пусть $\delta_{\text{eff}} = 5 \times 10^{-19}$ $Дж \cdot м^{-3}$ $\Rightarrow \Phi_{\text{mod}} / \delta_{\text{eff}} = 3.026 \times 10^{17}$ $Дж \cdot м^{-3}$. Тогда $\sigma_{\text{inf}} = 1.842 \times 10^{25}$ $бит/м^3$.

$$\rho_E^{\text{eff}} = \rho_E^0 + \eta_E (\sigma_{\text{inf}})^{\kappa_E}, \quad \rho_E^0 = 1.2 \cdot 10^5 \, Дж/м^3, \; \eta_E = 1.5 \times 10^{-31}, \; \kappa_E = 0.65.$$

$$\Rightarrow \Delta\rho_E \approx 0.604 \, кДж/м^3, \quad \rho_E^{\text{eff}} = 1.840 \, кДж/м^3 \; (+54\%).$$

Числа примерны для иллюстрации порядков и значения η_E, κ_E и реальном объеме зоне зависят от структуры.

Порядок $\eta_E \in [10^{-32}, 10^{-30}]$ соответствует типичным значениям в фотонных кристаллах при $\eta \approx 1550$ нм и модуляций масштаба $\sim 10^{25}$ [7].



Где Σ — пространственная размерность (10^{25} — 10^{30} бит/м³ при η_E — значение зависит от Σ). Самое важное: $\rho_E^{\text{eff}} - \rho_E^0 \approx \eta_E \sigma_{\text{inf}}^{\kappa_E} \approx 1.3$ $\eta_E \approx (1.5 \cdot 10^{-31} \cdot \kappa_E = 0.65)$. Поэтому — только порядок $\sim$ десятки из (1).

Рост сигнал выглядит экспоненциально, если фотоны (до) скорее показывает $\rho_E^{\text{eff}} \neq \rho_E^0 + \eta_E \sigma_{\text{inf}}^{\kappa_E}$. Такой характер связан с тем, что увеличение избыточной плотности информации усиливает показательную в зоне κ_E (см. §4). При большом σ_{inf} (или $\eta_E \sigma_{\text{inf}}^{\kappa_E}$) начинает ограничиваться так быстрый (экспоненциальный) рост на линейный закон Σ.

12. Связь с другими моделями НИИНУЛ

Модель динамического уплотнения энергии (DCE) может работать как самостоятельный эффект, но также как элемент более комплексных механизмов в рамках предложенных моделей:

- LUT (локальная линейная рекристаллизация): управляет кристаллическими потоками и пассивацией дефектов через параметр $R_{\text{LUT}} = P_{\text{LUT}} \cdot \sigma_{\text{inf}}^{\text{local}}$, повышая качество кристаллической структуры и эффективность η_{eff}.
- DEO (дополнительная задержка излучения): описывает дополнительную временную задержку излучения носителей τ_{DEO} на основе локальной информационной плотности σ_{inf}.
- DCE (динамическое уплотнение энергии): повышает локальную плотность энергии в материале за счёт пространственной избыточной информации σ_{inf} [37].

Совместное использование LUT+DEO+DCE позволяет масштабируемый алгоритм солнечных панелей: рекристаллизация → излучение → уплотнение.

См. также: [Модель LUT](#) — локальная линейная рекристаллизация

Модель DEO — дополнительная задержка излучения

Идея: основная часть энергии излучается быстро, но часть задерживается.

Что дал? – характеристика транзисторных слоёв + быстрый отклик + предсказуемость ИК.

Проверка: измерение ГРС, зависимость ИК от τ_{DEO} (через устройства).

Модель DCE — динамическое уплотнение энергии

Идея: основная плотность энергии растёт с избытком плотности информации сигнала/среды.

Что дал? – предсказательная теория + конкретные узлы фотонного кристалла + алгоритм активного слоя ФЭП без + зависимости.

Проверка: ρ_E^{eff} σ_{inf} измеряемая η_E, κ_E из фотодиодов на материал $\sigma_{\text{inf}} = \frac{R}{\tau_E}$.

12a. Методика расчёта индекса структурной упорядоченности Σ_{mod}

Индекс $\Sigma_{\text{mod}} \in [0, \infty]$ выбирается из списка ниже в зависимости от класса структуры. Он должен быть безразмерно мягкой одной величиной.

Многослой / фотонный кристалл

Определение. $\Sigma_{\text{mod}} = \left(\frac{\Delta n}{\langle n \rangle}\right)^2 D_f$, где $\Delta n = n_{\max} - n_{\min}$ — средние по слоям, а D_f — фрактальная размерность профиля толщин.

Алгоритм (box-counting):

1. Нормируйте последовательность толщин $\{\Delta L_i\}_{i=1}^{N}$ на $a_i = d_i / L_{\max}$.
2. Постройте покрытие по точкам $\{a_i\}$ покрытием ε-шаров (или равными ячейками ε).
3. Подсчитайте число занятых ячеек $N(\varepsilon)$, найдите наклон на участке линейности: $D_f = -\frac{d \log N(\varepsilon)}{d \log \varepsilon}$.

Неоднородное

Определение. $\Sigma_{\text{mod}} = \frac{\mathrm{Var}(\lambda)}{\langle \lambda \rangle}$.

Определение. Σ_{mod} (анизотропность по спектру): вычислите Фурье-анализ массива $\Sigma_{\text{mod}} = 1 - \frac{P_{\max}}{\sum_{k \neq 0} P_k}$, где $P_{\max}$ — мощность главной гармоники.

Квазикристалл / апериодическая последовательность

Определение. $\Sigma_{\text{mod}} = \frac{\sum_{k \neq 0} P_k}{\sum_k P_k}$ — доля квази-периодических компонент в фотонном дифракционном спектре (5-11).

Нормализация. Для сравнения между образцами допустимо линейное масштабирование $\Sigma_{\text{mod}} \mapsto \Sigma_{\text{mod}} / \Sigma_{\max}$, где $\Sigma_{\max}$ внутри серии фиксируется и протокол.

12b. Воспроизводимость (protocol)

1. Снимите и мощность вход: фиксируйте среднюю мощность на образце (болометром), погрешность отмер.
2. Параметр модуляции: измерьте B и ее амплитудную спектра, считать $R = B m^2$.
3. Протокол спектр: измерить η_E по дифференциальной зависимости $\Delta I = I_{\max} - I_{\min}$ $\eta_E = \frac{\tau_E \Delta I}{P \cdot \sigma_{\text{inf}}}$, $\kappa_E = \frac{d \log \rho_E^{\text{eff}}}{d \log \sigma_{\text{inf}}}$.
4. Подать мощ: изменить η_E (нелинейно/экспоненциально); метод фотоприема одинаковый для серии.
5. Термостабилизация: держать температуру ± 0.1 °C, иначе η_E может дрейфовать.
6. Термокомпенсация: датчик температуры ИК-камера / обязательно серия с дрейфом вашем материалом.
7. Вне параметров: не решая ρ_E^{eff} определить η_E, κ_E методом МНК, критерий качества $R^2 \geq 0.9$.
8. Отчетность: публикация сырых данных (CSV), описание кода подгонки и версию программы фреймов.

12c. Размерностной анализ коэффициента η_E

Пусть ρ_E имеет размерность $Дж \cdot м^{-3}$. Тогда из $\rho_E^{\text{eff}} = \rho_E^0 + \eta_E \sigma_{\text{inf}}^{\kappa_E}$ следует

$$[\eta_E] = [\rho_E / \sigma_{\text{inf}}^{\kappa_E}].$$

При $\kappa_E = 1$ получим $[\eta_E] = [Дж/бит]$, что перекликается с предыдущей оценкой Ландауэра $k_B T \ln 2$ но без его отношения к тепловой области, поскольку здесь нет операций информации (стирания).

12d. Явные приложения

- Фотонные кристаллы: буферизация данных и стабилизация световых импульсов без увеличения мощности.
- Квантовые системы: управление декогеренцией через пространственную структуру информационного буфера.
- Солнечные элементы: повышение КПД в многофазных материалах за счет более эффективного буферов.
- Квантовые узлы: управление энергии в квазикристаллах для более стабильной работы кубитов.

13. Краткая справка по оригинальности

Работа вводит измеримую величину материи σ_{inf} физико-математическую связь ρ_E^{eff}, дополнен с фактор Φ / ложи-трёх) плотностью [6]. Это прямой экспериментальный верификации корректно теоретическому результат как принципиальный термин энергии, поэтому физическая (§8) первым самом: ужесточ в вводится обеспечивается (§9).

14. Литература и связь с исследованиями

1. R. Landauer, "Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process," *IBM J. Res. Dev.*, vol. 5, pp. 183–191, 1961.
2. C. H. Bennett, "The thermodynamics of computation — a review," *Int. J. Theor. Phys.*, vol. 21, pp. 905–940, 1982.
3. J. M. R. Parrondo, J. M. Horowitz, and T. Sagawa, "Thermodynamics of information," *Nat. Phys.*, vol. 11, pp. 131–139, 2015.
4. M. del Rio, J. Rong, R. Renner, O. Dahlsten, and V. Vedral, "The thermodynamic meaning of negative entropy," *Nature*, vol. 474, pp. 61–63, 2011.
5. T. Baba, "Slow light in photonic crystals," *Nat. Photonics*, vol. 2, pp. 465–473, 2008.
6. M. Notomi, "Manipulating light with strongly modulated photonic crystals," *Rep. Prog. Phys.*, vol. 73, p. 096501, 2010.
7. E. Yablonovitch, T. J. Gmitter, R. D. Meade, A. M. Rappe, K. D. Brommer, J. D. Joannopoulos, "Donor and acceptor modes in photonic band structure," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 67, no. 24, pp. 3380–3383, 1991.
8. R. Vasilenko, A. Tarasiuk, T. Gozhva, and M. Notomi, "Demonstration of slow light in photonic crystal coupled waveguides," *Opt. Lett.*, vol. 45, pp. 2646–2649, 2020.
9. A. Kumar, Y. Liu, and T. T. Alkeskjold, "Slow light engineering in coupled-cavity waveguides," *Nat. Commun.*, vol. 15, p. 3316, 2024.
10. Y. Liu, A. Kumar, T. T. Alkeskjold, and M. Laurila, "Slow-light in photonic crystal waveguides," *Appl. Phys. Rev.*, vol. 11, p. 041409, 2024.
11. T. Mackenzie and A. Wu, "Bound states in the continuum in photonics," *Rev. Mod. Phys.*, vol. 93, p. 045001, 2021.
12. F. Wang et al., "Observation of bound states in the continuum in photonic crystals," *Nat. Commun.*, vol. 8, p. 2001, 2017.
13. Y. Liu, Y. Li, Z. Guo, and S. Fan, "Ultrafast dynamics of quasi-BIC modes," *Optica*, vol. 9, p. 1033, 2022.
14. Y. Liu, Y. Li, Z. Guo, and S. Fan, "Ultrafast dynamics of quasi-BIC modes," *Optica*, vol. 9, p. 1033, 2022.
15. Q. Hu, Y. Fang, Y. Li, and S. Zhang, "Roadmap on structured waves," *J. Opt.*, vol. 25, p. 023503, 2023.
16. J. Wang et al., "Twisted fiber space-time transmission employing orbital angular momentum multiplexing," *Nat. Photonics*, vol. 6, pp. 488–496, 2012.
17. S. Golowich, S. Lloyd, and L. Maccone, "Quantum thermodynamics of information," *Phys. Rev. A*, vol. 87, p. 052129, 2013.

Это работа формирует фундамент (термодинамика информации, спектр, БИС, спектроскопия) спектр. DCE может влиять между методику объектной плотности информации σ_{inf} как универсальной конструкции (дополнительная и отличная).

15. Протокол (детально) — Supplementary

Этот раздел дополняет §9 и §12b. Описан оборудования и шаги измерения η_E и κ_E для конкретного образца. Ключ: единый протокол и серия.

Оборудование

- Источник: лазер (CW/импульсный) на рабочей длине волны, совместимой с модуляцией.
- Модулятор: EOM/AOM для управления полосой B и глубиной m.
- Образец: фотонный кристалл / метаматериал / волновод.
- Детектор: фотодиод (PIN) или болометр, с известной чувствительностью.
- Термостат: ИК-камера / термопара.
- Контроль модуляции: анализатор спектра (осциллограф) амплитудная B, m).

Шаг 0 — Структурная метрика

Зафиксировать метод Σ_{mod} (см. §12a) и Δ_E — использовать неизменно в серии. Для многослоя $\Sigma_{\text{mod}} = \frac{\Delta n}{\langle n \rangle} D_f$, $\Delta_E = \varepsilon$.

Шаг 1 — Калибровка сигнала

1. Измерить мощность на образце (болометр).
2. Режимы: P (Вт), B (спектр), m.
3. Измерить $R = Bm$ по сигналам всех B и P вместе.

Аппроксимация (вместо при известной B): $R \approx B \log_2(1 + SNR)$. Важно: внутри одной серии использовать одну аппроксимацию B.

Шаг 2 — Грубая оценка (экспоненциальная)

При изменении дифференциальной задержки относительно внешнего тай мы решаем: $\Delta I = I_{\max} - I_{\min}$. Тогда суточный показатель $\eta_E = 1 + \frac{\tau_E \Delta I}{P \cdot \sigma_{\text{inf}}}$, $\kappa_E = \frac{\tau_E}{\sigma_{\text{inf}}}$. (Если результат обеспечения η_{eff} зависимо $\eta_E < 4$ η_{eff}).

Шаг 3 — Эффективная площадь

По части интенсивности $I(x, y)$. Аналог $A_{\text{eff}} = \frac{(\int I \, dx \, dy)^2}{\int I^2 \, dx \, dy}$.

Шаг 4 — Локальная плотность энергии

- κ_E Равномерная засветка: $\rho_E = \frac{P \cdot \Delta t}{A_{\text{eff}} \cdot d}$.
- κ_E Локальный нагрев (термометр): $\Delta T(x, y)$, $\rho_E \propto \rho_E^0 C_p \Delta T(x, y)$.
- κ_E Импульсное (Кюре): слабый импульс Δt и ΔT — также показатели $\rho_E = \frac{\rho_E^0}{\Delta T}$.

Шаг 5 — Расчет ρ_E и ρ_{inf}

$\sigma_{\text{inf}} = \frac{R}{\tau_E}$. Для каждой конфигурации берём $\Delta\rho_E = \rho_E^{\text{on}} - \rho_E^{\text{off}}$ и κ тот масштаб: $\ln \Delta\rho_E = \ln \eta_E + \kappa_E \ln \sigma_{\text{inf}}$.

Шаг 6 — Расчет η_E и κ_E

κ_E — $\frac{d \ln \rho_E}{d \ln \sigma_{\text{inf}}}$. Для каждой конфигурации берём $\Delta\rho_E = \rho_E^{\text{on}} - \rho_E^{\text{off}}$ и κ тот масштаб: $\ln \Delta\rho_E = \ln \eta_E + \kappa_E \ln \sigma_{\text{inf}}$.

Шаг 7 — Контроль и воспроизводимость

- Единый метод Σ_{mod} для ρ_E и Σ_{mod} (см. §12a).
- При оценке κ_E использовать дифференциальное значение: $\Delta I = I_{\max} - I_{\min}$, $\kappa_E = 1 + \frac{\tau_E \Delta I}{P \cdot \sigma_{\text{inf}}}$, $\kappa_E = \frac{\tau_E}{\sigma_{\text{inf}}}$.
- Указывать, какие измерения B применялись ($\Delta\rho_E^{\text{on}}$ или $B \log_2(1 + SNR)$).

16. Математическая модель

Базовая феноменология: $\rho_E^{\text{eff}} = \rho_E^0 + \eta_E \sigma_{\text{inf}}^{\kappa_E}$. Для работающей модуляции по умолчанию берём $R = B m^2$, $\tau_{\text{material}} = R = B$ $бит/с$ $\Rightarrow$ $\sigma_{\text{inf}} = \frac{B}{\tau_E}$.

16.1 Оценка параметров κ_E и η_E (без кода).

1. Для каждой конфигурации с измерить Φ_i, $\sigma_{\text{inf},i}$, $\Delta\rho_{E,i}$, $\Delta\rho_{E,i}^{\text{eff}}$.
2. Построить Φ_i по выбранной реализации: $\Phi_i = \Sigma_{\text{mod},i} \cdot \Delta\rho_{E,i}^{\text{eff}}$, потом $\sigma_{\text{inf},i} = (\Phi_i / \eta_E)^{\frac{1}{\kappa_E}}$.
3. Определить $\Delta\rho_{E,i} = \rho_E^{\text{on}} - \rho_E^{\text{off}}$ и перейти к ln: масштаб: $x_i = \ln \sigma_{\text{inf},i}$, $y_i = \ln \Delta\rho_{E,i}$.
4. Линейная регрессия $y = a + b x$ для пар:

$$x_i = \ln \quad \ln \eta_E = a$$

В зависимости мощ (МНК для N точек):

$$b = \frac{N \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad a = \frac{\sum y_i - b \sum x_i}{N}.$$

5. Качество апроксимации: $R^2 \geq 0.9$. Отличие указывать важные от отдельных точек. Аномальные.

16.2 Спектральная интегральная (если источник нормализован)

При зависимости от длины волны используем интеграл

$$\sigma_{\text{inf}} = \int \frac{R(\lambda)}{\tau_E(\lambda)} d\lambda, \qquad \Phi(\lambda) = \frac{\Phi_{\text{mod}}(\lambda)}{\rho_E(\lambda)}.$$

Для дискретного спектра $\{\lambda_i\}$ с весом $\Delta\lambda_i$

$$\sigma_{\text{inf}} = \sum_i \frac{R_i}{\tau_{E,i}} \Delta\lambda_i.$$

16.3 Зависимости и точности

- Каждая методика в серии для ρ_E и Σ_{mod} (см. §12a).
- При оценке κ_E использовать дифференциальное значение: $\Delta I = I_{\max} - I_{\min}$, $\kappa_E = 1 + \frac{\tau_E \Delta I}{P \cdot \sigma_{\text{inf}}}$, $\kappa_E = \frac{\tau_E}{\sigma_{\text{inf}}}$.
- Указывать, какие измерения B применялись ($\Delta\rho_E^{\text{on}}$ или $B \log_2(1 + SNR)$).

17. Глоссарий (краткий)

- ρ_E^{eff} — объёмная плотность информации (бит·м⁻³ = $Дж/м^3$).
- ρ_E^0 — базовая объёмная плотность энергии ($Дж/м^3$).
- η_E — скоростная емкость ($м/с$).
- Φ — структурная метрика = $\Sigma_{\text{mod}} \cdot \Delta\rho_E^{\text{eff}}$.
- σ_{inf} — пространственная масштаб ($бит/м^3$).
- η_E, κ_E — параметры фита эмпир. преобразования и показатель чувствительности.

Лицензия (RU)

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ

Автор и обладатель прав: Профессор Нунуляр.
Контакты: https://t.me/NUNUL1 | cloud@ya.com

1. Настоящая разработка является интеллектуальной собственностью автора и охраняется международным правом.
2. Любое копирование, распространение, модификация, коммерческое или некоммерческое использование без письменного разрешения автора запрещено.
3. Запрещается использование или интеграция данной разработки, полностью или частично, в военную, авиационную, космическую или ядерную промышленность.
4. Исключительные права сохраняются за автором.
5. Для получения разрешения необходимо обратиться по указанным контактам или условиям.
6. Запрещается ремикс-использование, декомпилирование или обход технических ограничений.
7. Нарушение данных условий влечёт ответственность в соответствии с законодательством, а авторские права сохраняются. Договор ВСЕМС по авторскому праву. Соглашение TRIPS, а также национальным законодательством стран нарушителя.

© Профессор Нунуляр. Все права защищены.

License (EN)

LICENSE FOR USE OF THE DEVELOPMENT

Author and Rights Holder: Professor Nonsa
Contacts: https://t.me/NUNUL1 | cloud@ya.com

1. This development is the intellectual property of the author and is protected under international law.
2. Any copying, distribution, modification, commercial or non-commercial use without the author's written permission is prohibited.
3. Patent applications or registrations based on this material are strictly forbidden without the author's consent.
4. All rights are reserved by the author.
5. Permission can only be granted through an official written agreement via the provided contacts.
6. Reverse engineering, decompilation, or circumvention of technical restrictions is prohibited.
7. Violation of these terms entails liability in accordance with the legislation, Berne Convention, WIPO Copyright Treaty, TRIPS Agreement, as well as the national laws of the violator's country.

© Professor Nonsa. All rights reserved.